111 年度工研院材料與化工研究所

5G 高頻通訊基板相關材料等相關研發成果非專屬授權案

- 一、主辦單位:財團法人工業技術研究院(以下簡稱「工研院」)
- 二、非專屬授權標的:5G 高頻通訊基板相關材料等相關研發成果,共計25 案72 件獲 證及申請中專利。詳細資訊請參「附件:授權標的清單」。
- 三、非專屬授權廠商資格:國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造 或銷售之公司法人。

四、公開說明會:

- (一)舉辦時間:民國(下同)111年6月30日14時。
- (二)舉辦地點:線上公開說明會。
- (三)報名須知:採電子郵件方式報名。有意報名者,請於111年6月29日12時整(含)前以電子郵件向本案聯絡人報名(主旨請註明「111年度工研院材料與化工研究所5G高頻通訊基板相關材料等相關研發成果非專屬授權案公開說明會報名」,並於內文中註明:公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱)。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於111年6月29日17時整(含)前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。

五、聯絡人:

工研院技術移轉與法律中心 李小姐

電話: 03-5917759

傳真: 03-5820466

電子信箱: lislee@itri.org.tw

地址:310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

附件:授權標的清單

案號	案號	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	委辨	授權		
-		.,,	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		<i>"</i>	1 1/4 2/1 1/2		,		單位	紀錄		
		P54080	碳化矽粉體的純化方法	中華	獲證	108140793	I698397	20200711	20391110	經濟部			
	1	040TW		民國	V					技術處			
	•	P54080	碳化矽粉體的純化方法	美國	獲證	16/729,065	11046582	20210629	20400402	經濟部			
-		040US	- Note of the second se	7,1	7,	10/725,005	11010302	20210029	20100102	技術處			
5G 半導體		P54080	低介電材料與其形成方	日本	審查中	2020-214024				經濟部			
/LTCC 元		070JP	法		821	2020 21 102 1				技術處			
件材		P54080	低介電材料與其形成方	中華						經濟部			
	2	070TW	法	民國	審查中	109145693							
		C1		,,,,						2.1172			
		P54080	低介電材料與其形成方	美國	審查中	17/133,270				經濟部			
		070US	法	7,1	4 - 1	177133,270				技術處			
		P54050	銅箔複材	中國	獲證	201611257153.	CN108267	20210330	技術處 技術處				
	3	059CN	217H JX 117	大陸	7又证	X	870	20210330	20301229	技術處			
	3	P54050	銅箔複材	中華	獲證	105144023	I607866	20171211	20361229	經濟部			
_		059TW	217G 1X 11	民國	7 <u>7</u> tuz	103144023	1007000	20171211	2030122)	技術處			
		P54060	底漆組成物與使用該底	中國	獲證	201810552437.4	CN109385	20210427	20380530	經濟部			
		022CN	漆組成物的銅箔基板	大陸	7.2 00	201010332437.4	174	20210427	20300330	技術處			
	4	P54060	底漆組成物與使用該底	中華	獲證	107113094	I702264	20200821	20380416	电 电放經技經技經技經技經技經技經技經技經技經技經技經技經技經技經技經技經技經技經技			
	7	022TW	漆組成物之銅箔基板	民國	72.55	10/1130/1	1702204	20200021	20300110	技術處			
		P54060	底漆組成物與使用該底	美國	獲證	16/057,779	10917964	20210209	20390101	技術處			
		022US	漆組成物之銅箔基板	<u>, Д</u>	7.2 00	10/03/,///	10717704	20210207	20370101	技術處			
		P54060	高頻電路用銅箔及其製							 			
	5	023US	造方法	美國	審查中	審查中 1	審查中	16/917,914					
高頻銅箔 -		D1	10 / IA							7文7的 灰色			
可少只到7日		P54080	底漆組合物及積層板	中國	宴杰山	202010493214.2				經濟部			
		080CN	瓜然	大陸	田旦丁	202010433214.2				經技經技經技經技經技 經技 經技經技經技經技經按經技經技經技經技經技經技經技經技			
	6	P54080	底漆組合物及積層板	中華	獲證	108148599	1721527	20210621	20201220	經濟部			
	O	080TW	瓜 徐 組 石 初 及 傾 信	民國	 後證		1731537	20210021	20391230	技術處			
		P54080	底漆組合物及積層板	美國	宏杰由	16/010 610				經濟部			
		080US	広 徐組合初及積層	夫四	番 鱼 干	16/919,619				技術處			
		P54060	基板組合物及由其所製	中國	磁战	201010025042 1	CN109912	20210519	20290724	經濟部			
		043CN	備的基板	大陸	獲證	201810825043.1	908	20210518	20380724	技術處	L v		
		P54060	甘仁和土物工工廿公制	山坡	獲證					细液如			
	7	043TW	基板組成物及由其所製	中華民國		107121300	1695033	20200601	20380620		v		
		C1	備之基板							投 們處			
		P54060	基板組成物及由其所製	¥ 国	在北	16/116 706	10640627	20200505	20290014	經濟部			
		0.427.70	備之基板	美國	獲證	16/116,706	10640637	20200505	20380914	11. 11- 4	V		

案號	案號	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期		授權紀錄
		P54100	電磁波吸收材及用於抑	中華						經濟部	
	8	079TW	制電磁干擾的複合結構	民國	審查中	110149762				技術處	
			電磁特性量測裝置與系	, _							
		P54080	統以及電磁特性量測方	中國	審查中	202011505966.2					
		077CN	法	大陸						投術處	
		P54080	電磁特性量測裝置、電								
		077JP	磁特性量測系統以及電	日本	審查中	2020-210577					
5G EMI 複	9	07731	磁特性量測方法							1文7的 灰色	
材及量測		P54080	電磁特性量測裝置、電	中華						經濟部	
技術		077TW	磁特性量測系統以及電	民國	審查中	109144906					
		0,,1,,	磁特性量測方法							201170	
		P54080	電磁特性量測裝置、電							經濟部	
		077US	磁特性量測系統以及電	美國	審查中	17/126,025				技術處	
			磁特性量測方法								
		P54010	屏蔽複合膜片	中國	獲證	201210579784.9	CN103889	20161228	20321226		
	10	072CN		大陸			197				
		P54010	屏蔽複合膜片	中華民國	獲證	101149188	I482585	20150421	20321220		
		072TW	化合物、樹脂組合物、	八四							
		034US	及積層板	美國	審查中	17/138,254					
			化合物、樹脂組合物、	中華		17/130,234					
	11		及積層板	民國	審查中	110116722					
			聚醯亞胺樹脂前驅物及	中國		20211043568				經技 經技 經技 經技經技經技經技經技 經技 經技 經技經技經技經技 經技 經技	
		034CN	其應用	大陸	審查中	9.0				技術處	
		P54060	感光型複合材料及使用	中國	審查中	201811511723.2				經濟部	
		037CN	其形成複合薄膜的方法	大陸						技術處	
		P54060	式 小 叫 治 人 	上 #						單經技 經技 經技 經技 經技 經技經技經技經技經技經技經技經技經技經技經技經技	
5G 高頻	12	037TW	感光型複合材料及使用 其形成複合薄膜之方法	中華民國	獲證	107137184	I691535	20200421	20381021		
MPI 軟板		C1	共心成後日 母族之为 么	八四							
材料		P54060	感光型複合材料及使用	美國	獲證	16/226,147	11106134	20210831	20390414	經濟部	
		037US	其形成複合薄膜之方法	ХД	7文 6年	10/220,147	11100134	20210031	20370414	技術處	
		P54100	聚醯亞胺、薄膜組合物	中國	審查中	202111612689.				經濟部	
			及其所形成之薄膜	大陸		X					
			聚醯亞胺、薄膜組合物	日本	審查中	2021-214037					
	13	008JP	及其所形成之薄膜								
			聚醯亞胺、薄膜組合物	中華	審查中	110145399					
			及其所形成之薄膜	民國							
			聚醯亞胺、薄膜組合物	美國	審查中	17/564,997					
		008US	及其所形成之薄膜							投術 處	

案號	案號	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	委辨 單位	授權紀錄
			感光組合物及其所形成 的薄膜	中國大陸	審查中	202210306158.6				經濟部 技術處	
	15	P54110	感光組合物及其所形成 之薄膜	中華民國	審查中	111111400				經濟部 技術處	
		P54100		中國大陸	審查中	202210253455.9				經濟部 技術處	
		P54100	酸酐化合物、聚醯亞 胺、與薄膜	中華民國	審查中	110145616				經濟部 技術處	
		P54080	液晶聚合物、積層材料、液晶聚合物溶液與液晶聚合物薄膜的形成方法	中國	審查中	202010585756.2				經濟部技術處	V
		P54080 018CN A1	液晶聚合物、積層材料、液晶聚合物溶液與 液晶聚合物薄膜的形成 方法		審查中	202010615947.9				經濟部技術處	V
		P54080 018EP	液晶聚合物、積層材料、液晶聚合物溶液、 與液晶聚合物薄膜的形成方法	EPC/ 歐盟	審查中	20182251.7				經濟部技術處	
5G 高頻		P54080 018EP A1	液晶聚合物、積層材料、液晶聚合物溶液、 與液晶聚合物薄膜的形成方法	EPC/ 歐盟	審查中	20183612.9				經濟部 技術處	
LCP 軟板 材料	16	P54080 018JP	液晶聚合物、積層材料、液晶聚合物溶液、 與液晶聚合物薄膜的形 成方法	日本	審查中	2020-113162				經濟部技術處	
		P54080 018JPA 1	液晶聚合物、積層材料、液晶聚合物溶液、 與液晶聚合物薄膜的形成方法	日本	審查中	2020-113762				經濟部技術處	
			液晶聚合物、積層材料、液晶聚合物溶液、 與液晶聚合物薄膜的形 成方法	中華民國	審查中	109112311				經濟部 技術處	v
		P54080 018TW A1	液晶聚合物、積層材料、液晶聚合物溶液、 與液晶聚合物薄膜的形成方法	中華民國	獲證	109121301	1727835	20210511	20400622	經濟部 技術處	V

案號	案號	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	委辨 單位	授權紀錄
			液晶聚合物、積層材 料、液晶聚合物溶液、 與液晶聚合物薄膜的形 成方法	美國	審查中	16/918,551				經濟部 技術處	
		P54080 018US A1	液晶聚合物、積層材料、液晶聚合物溶液、 與液晶聚合物薄膜的形成方法	美國	審查中	16/918,990				經濟部技術處	
	17	P54070 021US	薄膜組成物及其所形成 之薄膜	美國	獲證	16/593,320	11059938	20210713	20400311	經濟部 技術處	
			寡聚物、包含其的組合 物及複合材料	中國大陸	獲證	201611270235.8	CN107417 862	20190823	20361229	經濟部 技術處	
	18		寨聚物、包含其之組成 物及複合材料	中華民國	獲證	105144141	I606076	20171121	20361229	經濟部 技術處	
			寡聚物、包含其之組成 物及複合材料	美國	獲證	15/395,599	10179833	20190115	20370811	經濟部 技術處	
5G 高頻樹		P54050 044CN C1	寡聚物、包含其的組合 物及複合材料	中國大陸	獲證	201711391873. X	CN108250 720	20210323	20371220	經濟部 技術處	v
脂材料	19	P54050 044TW C1	寡聚物、包含其之組成 物及複合材料	中華民國	獲證	106145046	I676641	20191111	20371220	經濟部 技術處	v
		P54050 044US C1	寡聚物、包含其之組成 物及複合材料	美國	獲證	15/851,309	10844164	20201124	20370309	經濟部 技術處	v
		P54040 086CN	聚苯醚寡聚物及高頻銅 箔基板	中國大陸	獲證	201611192062.2	CN107022 075	20190628	20361220	經濟部 技術處	
	20	P54040 086TW	聚苯醚寡聚物及高頻銅 箔基板	中華民國	獲證	105142422	I621679	20180421	20361220	經濟部 技術處	
		P54040 086US	聚苯醚寡聚物及高頻銅 箔基板	美國	獲證	15/386,669	10358585	20190723	20371225	經濟部 技術處	
		P54090 041CN	共聚物與複合材料	中國 大陸	審查中	202110695971.2				經濟部 技術處	
5G 低介電 低耗損絕	21	P54090 041TW	共聚物與複合材料	中華民國	審查中	110116352				經濟部 技術處	
緣/增層/封 裝材		P54090 041US	共聚物與複合材料	美國	審查中	17/497,673				經濟部技術處	
	22		樹脂化合物以及包含其 的樹脂組合物	中國大陸	審查中	202210155445				經濟部 技術處	

案號 案號	华 贴	사 선 타	从 46 基 - 黄 41 夕 40	四台小	비는 4F	do ado de vis		# 41 는 110	# 4.1 \h lin	委辨	授權
系统	茶 號	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請案號	公告號	專利起期	导利迈期	單位	紀錄
		P54100	樹脂化合物以及包含其	中華	宏木山	110115				經濟部	
		033TW	之樹脂組合物	民國	番鱼牛	110145160				技術處	
		P54100	樹脂化合物以及包含其	美國	宏木山	17/590,530				經濟部	
		033US	之樹脂組合物	夫四	番 旦 干	17/390,330				技術處	
		P54060	組成物、包含其的絕緣	中國	宏木山	201011500540 5				經濟部	
		086CN	材料及其製法	大陸	審查中	201811598548.5				技術處	
	23	P54060	組成物、包含其之絕緣	中華	磁战	107147192	I683852	20200201	20381225	經濟部	
		086TW	材料及其製法	民國	獲證					技術處	
		P54060	組成物、包含其之絕緣	美國	獲證	16/232,766	11118082	20210914	20390807	經濟部	
		086US	材料及其製法	天四						技術處	
		P54100	共聚物、樹脂、與複合	中國	審查中	202210146890.1				經濟部	
	24	074CN	材料	大陸						技術處	
		P54100	共聚物、樹脂、與複合	中華	審查中	110149262				經濟部	
		074TW	材料	民國						技術處	
		P54090	聚合物及包含其之樹脂	中國	宏木山	2.0211E+11				經濟部	
		035CN	組合物	大陸	番鱼甲	中 2.0211E+11				技術處	
	25	P54090	聚合物及包含其之樹脂	中華	+ +	110103657				經濟部	
		035TW	組合物	民國	番 旦 中	110103037				技術處	V
		P54090	聚合物及包含其之樹脂	美國	宏杰山	17/120 000				經濟部	
		035US	組合物	美國	番 笪 中	中 17/139,088				技術處	V